

Содержание

Международная конференция Физика.СПб/2025 . 189

Салий Р.А., Малевская А.В., Малевский Д.А., Минтаилов С.А., Надточий А.М., Калюжный Н.А.

Экспериментально-аналитическое исследование проблемы компенсации механических напряжений в системе InGaAs множественных квантовых ям для излучателей ближнего инфракрасного диапазона 190

Сибирев Н.В., Штром И.В.

Управление направлением роста планарных нитевидных нанокристаллов 195

Стецюра С.В., Харитонов П.Г., Козловский А.В.

Модификация поверхности CdS при нанесении и отжиге структурированного металлом органического покрытия . 199

Покровский П.В., Хвостиков В.П., Малевская А.В., Хвостикова О.А.

Особенности тестирования микроразмерных фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения 205

Романчук А.К., Малевская А.В., Калюжный Н.А., Нахимович М.В., Шварц М.З., Андреев В.М.

Увеличение эффективности ввода оптической мощности в AlGaAs/GaAs фотоэлектрических преобразователях лазерного излучения 209

Левина С.А., Емельянов В.М., Корниенко П.Д., Ларионов В.Р., Нахимович М.В., Шварц М.З.

Исследование времен жизни неравновесных носителей заряда электролюминесцентным методом в многопереходных солнечных элементах при облучении протонами и электронами высоких энергий 214

Минтаилов М.А., Евстропов В.В., Калюжный Н.А., Минтаилов С.А., Нахимович М.В., Шварц М.З.

Определение дисбаланса фотогенерированных токов в многопереходных фотопреобразователях лазерного излучения 219

Михайлов О.П., Баранов А.И., Максимова А.А., Уваров А.В., Вячеславова Е.А., Гудовских А.С.

Исследование влияния облучения потоком электронов на фотоэлектрические свойства солнечных элементов на основе наноструктурированного „черного“ кремния с пассивирующим слоем n-GaP 223

Лебедев А.А., Козловский В.В., Малевский Д.А., Сахаров А.В., Давыдовская К.С., Левинштейн М.Е., Николаев А.Е.

Влияние температуры облучения на скорость удаления носителей в GaN 227

Елисеев И.А., Kurtash V.A., Pezoldt J., Давыдов В.Ю.

Управление плотностью носителей заряда в фототранзисторных структурах на основе CVD-MoS₂ атомарной толщины 230

• **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Блошкин А.А., Якимов А.И.

Повышение эффективности фотоприемных структур на основе квантовых точек Ge/Si модами фотонного кристалла в среднем инфракрасном диапазоне 235

• **Физика полупроводниковых приборов**

Демидов Е.В., Захаров В.Е., Шмагин В.Б., Яблонский А.Н., Новиков А.В.

Моделирование транспортных и излучательных характеристик светоизлучающего латерального кремниевого $p^+ - i - n^+$ -транзистора с самоформирующимися Ge(Si)-наноостровками 242